



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2008-0006998
(43) 공개일자 2008년01월17일

(51) Int. Cl.

H05B 33/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2006-0066444

(22) 출원일자 2006년07월14일

심사청구일자 2006년07월14일

(71) 출원인

삼성에스디아이 주식회사

경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자

곽노민

경기 용인시 기흥구 공세동 삼성SDI중앙연구소

강태민

경기 용인시 기흥구 공세동 삼성SDI중앙연구소

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

박상수

전체 청구항 수 : 총 18 항

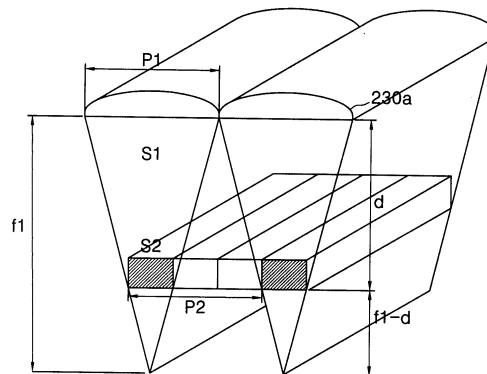
(54) 레이저 조사장치 및 그를 이용한 유기전계발광소자의제조방법

(57) 요약

본 발명은 다양한 픽셀배치 방법을 실행할 수 있는 레이저 조사장치 및 그를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법에 관한 것으로, 광원장치; 상기 광원장치 하부에 위치하는 시준렌즈(collimation lens); 상기 시준렌즈 하부에 위치하는 대칭 디오이 렌즈 어레이(symmetrical DOE lens array); 및 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이 하부에 위치하는 마스크를 포함하는 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치를 제공한다.

또한, 본 발명은 제 1 전극이 형성된 기판을 제공하고; 기재층, 상기 기재층 상에 광-열변환층 및 상기 광-열변환층 상에 전사층이 차례로 적층된 구조로 제조된 도너기판을 제공하고; 상기 전사층이 상기 기판과 대향하도록 서로 이격되어 배치하고; 광원장치, 시준렌즈, 대칭 디오이 렌즈 어레이 및 마스크를 포함하는 레이저 조사장치를 이용하여 상기 기재층의 일부 영역에 레이저를 조사하여 상기 전사층의 전사를 수행하여 상기 기판 상에 유기막층 패턴을 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광소자의 제조방법을 제공한다.

대표도 - 도3b



(72) 발명자

이재호

경기 용인시 기흥구 공세동 삼성SDI중앙연구소

이성택

경기 용인시 기흥구 공세동 삼성SDI중앙연구소

특허청구의 범위

청구항 1

광원장치;

상기 광원장치 하부에 위치하는 시준렌즈(collimation lens);

상기 시준렌즈 하부에 위치하는 대칭 디오이 렌즈 어레이(symmetrical DOE lens array); 및

상기 대칭 디오이 렌즈 어레이 하부에 위치하는 마스크를 포함하는 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈 어레이는 투명성 재질로 이루어진 복수의 대칭 디오이 렌즈의 조합으로 이루어진 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈 어레이는 상기 시준렌즈와 상기 마스크 사이를 상하로 이동 가능한 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈의 형상은 반구 형상, 블레이즈(blaze)형상, 계단 형상 및 관상 형상 중에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈의 초점거리는 10~300mm 인 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈의 지름은 60~500 μ m 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 마스크는 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이 중 일부 대칭 디오이 렌즈를 통과한 레이저빔을 차단하는 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 8

제 2 항에 있어서,

상기 투명성 재질은 유리 또는 투명성 플라스틱인 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치.

청구항 9

제 1 전극이 형성된 기판을 제공하고;

기재층, 상기 기재층 상에 광-열변환층 및 상기 광-열변환층 상에 전사층이 차례로 적층된 구조로 제조된 도너 기판을 제공하고;

상기 전사층이 상기 기관과 대향하도록 서로 이격되어 배치하고;

광원장치, 시준렌즈, 대칭 디오이 렌즈 어레이 및 마스크를 포함하는 레이저 조사장치를 이용하여 상기 기재층의 일부 영역에 레이저를 조사하여 상기 전사층의 전사를 수행하여 상기 기관 상에 유기막층 패턴을 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 도너기관은 상기 광-열변환층과 상기 버퍼층 사이에 가스생성층을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 11

제 9 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈 어레이는 투명성 재질로 이루어진 복수의 대칭 디오이 렌즈의 조합으로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 12

제 9 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈 어레이는 상기 시준렌즈와 상기 마스크 사이를 상하로 이동 가능한 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 13

제 9 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈의 형상은 반구 형상, 블레이즈(blaze)형상, 계단 형상 및 판상 형상 중에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 14

제 9 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈의 초점거리는 10~300mm 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 15

제 8 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈의 지름은 60~500 μ m 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 16

제 8 항에 있어서,

상기 대칭 디오이 렌즈와 상기 도너기관과의 거리는 20/3~200mm인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 17

제 8 항에 있어서,

상기 유기막층 패턴의 크기는 20~500/3 μ m 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

청구항 18

제 8 항에 있어서,

상기 레이저 조사장치는 멀티 스캔 방식으로 수행되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자의 제조방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

- <7> 본 발명은 레이저 조사장치 및 그를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 레이저 조사장치에서 패터닝하고자 하는 화소를 정의하는 대칭 디오이 렌즈 어레이 및 다양한 픽셀배치 방법을 실행할 수 있는 마스크를 포함하는 레이저 조사장치 및 이를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법에 관한 것이다.
- <8> 일반적으로 평판표시소자인 유기전계발광소자는 애노드 전극과 캐소드 전극 그리고 상기 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 개재된 유기막층을 포함한다. 상기 유기막층은 적어도 유기발광층을 포함한다. 이러한 유기전계발광소자는 상기 유기발광층을 이루는 물질에 따라서 고분자 유기전계발광소자와 저분자 유기전계발광소자로 나누어진다.
- <9> 이러한 유기전계발광소자에 있어 풀칼라화를 구현하기 위해서는 R, G, B의 삼원색을 나타내는 각각의 발광층을 패터닝해야 한다. 여기서 상기 발광층을 패터닝하기 위한 방법으로 저분자 유기전계발광소자의 경우 새도우 마스크(shadow mask)를 사용하는 방법이 있고, 고분자 유기전계발광소자의 경우 잉크젯 프린팅(ink jet printing) 또는 레이저 열전사법(Laser Induced Thermal Imaging; 이하 LITI라 한다.)이 있다. 이 중에서 상기 LITI는 상기 유기막층을 미세하게 패터닝할 수 있고, 대면적에 사용할 수 있으며 고해상도에 유리하다는 장점이 있을 뿐만 아니라, 상기 잉크젯 프린팅이 습식 공정인데 반해 이는 건식 공정이라는 장점이 있다.
- <10> 도 1 은 종래의 레이저 조사장치를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법을 설명한 모식도이다.
- <11> 도 1을 참조하면, 제 1 전극(162)이 형성된 기판(161)을 제공한다. 상기 제 1 전극(162)과 상기 기판(161) 사이에 박막트랜지스터, 절연막 및 캐패시터 등을 포함할 수 있다.
- <12> 이어서, 상기 기판(161) 상에 레이저 전사용 도너기판(150)을 라미네이션(lamination)한다. 여기서, 상기 도너기판(150)은 기재층(151), 상기 기재층(151) 상에 광-열변환층(152) 및 상기 광-열변환층(152) 상에 전사층(153)이 차례로 적층된 구조로 제공된다.
- <13> 한편, 상기 기판(161)과 상기 도너기판(150)과는 별도로 레이저 조사장치(100)가 제공된다. 상기 레이저 조사장치(100)는 광원장치(110), 패터닝되어 있는 마스크(120) 및 프로젝션 렌즈(130)를 포함하고 있다.
- <14> 이어서, 상기 광원장치(110)에서 발생한 레이저빔(140)은 패터닝되어 있는 상기 마스크(120)를 통과하고, 상기 통과한 레이저빔(140)은 상기 프로젝션 렌즈(130)에 의해 굴절되어 상기 기재층(151)의 일부 영역에 조사된다.
- <15> 상기 기재층(151)의 일부 영역에 조사된 상기 레이저빔(140)은 상기 광-열변환층(152)에서 흡수되어 열에너지로 변환된다. 흡수된 열에너지에 의해 상기 광-열변환층(152)은 상기 전사층(153)을 상기 기판(161)상에 밀착시킨다. 이어서, 밀착된 상기 전사층(153)의 결합이 끊어지면서 상기 전사층(153)은 상기 기판(161) 상으로 전사되어 유기막층 패터닝(미도시)을 형성한다.
- <16> 도 2 는 종래의 레이저 조사장치를 이용하여 패터닝한 화소를 나타낸 평면도이다.
- <17> 도 2를 참조하면, 상기 기판(161)의 각 픽셀에 레드(R), 블루(B), 그린(G) 등의 단위화소 중 하나인 레드 화소가 레이저 스캔방향으로 패터닝되어 있다.
- <18> 그러나 종래의 레이저 조사장치는 레이저 스캔방향으로 각 픽셀에 레드(R), 블루(B), 그린(G)등의 단위화소들 중 하나의 단위화소만 패터닝을 해야하므로 같은 레이저 스캔방향으로는 다른 색의 단위화소를 패터닝 할 수 없고, 또한 스트라이프 형태로만 패터닝을 해야 하는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- <19> 따라서 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로 다양한 픽셀 배치 방법 등에 대응할 수 있는 레이저 조사장치 및 그를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

- <20> 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 다양한 픽셀 배치 방법에 대응할 수 있는 레이저 조사장치 및 그를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법에 관한 것으로, 광원장치; 상기 광원장치 하부에 위치하는 시준렌즈(collimation lens); 상기 시준렌즈 하부에 위치하는 대칭 디오이 렌즈 어레이(symmetrical DOE lens array); 및 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이 하부에 위치하는 마스크를 포함하는 것을 특징으로 하는 레이저 조사장치를 제공한다.
- <21> 또한, 본 발명은 제 1 전극이 형성된 기판을 제공하고; 기재층, 상기 기재층 상에 광-열변환층 및 상기 광-열변환층 상에 전사층이 차례로 적층된 구조로 제조된 도너기판을 제공하고; 상기 전사층이 상기 기판과 대향하도록 서로 이격되어 배치하고; 광원장치, 시준렌즈, 대칭 디오이 렌즈 어레이 및 마스크를 포함하는 레이저 조사장치를 이용하여 상기 기재층의 일부 영역에 레이저를 조사하여 상기 전사층의 전사를 수행하여 상기 기판 상에 유기막층 패턴을 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광소자의 제조방법을 제공한다.
- <22> 이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 그러나 본 발명은 여기서 설명되어지는 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 도면들에 있어서, 층이 다른 층 또는 기판 “상”에 있다고 언급되어지는 경우에 그것은 다른 층 또는 기판 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 층이 개재될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소를 나타낸다.
- <23> 도 3a는 본 발명에 의한 레이저 조사장치 및 유기전계발광소자의 제조방법을 설명하는 모식도이다.
- <24> 도 3a를 참조하면, 제 1 전극(262)이 형성되어 있는 기판(261)을 제공한다. 상기 기판(261)과 상기 제 1 전극(262) 사이에는 박막트랜지스터, 절연막 및 캐패시터 등이 포함될 수도 있다.
- <25> 한편, 상기 기판(261)과는 별도로 레이저 전사용 도너기판(250)을 제공한다. 상기 도너기판(250)은 기재층(251), 상기 기재층(251) 상에 광-열변환층(252) 및 상기 광-열변환층(252) 상에 전사층(253)이 적층되어 있는 구조이다. 또한, 상기 광-열변환층(252)과 상기 전사층(253) 사이에는 가스생성층(미도시)이 더욱 포함될 수도 있다.
- <26> 상기 기재층(251)은 상기 광-열변환층(252)에 빛을 전달하기 위하여 투명성을 가져야 하며, 적당한 광학적 성질과 충분한 기계적 안정성을 가진 물질로 이루어질 수 있다. 예를 들면, 폴리에스테르, 폴리아크릴, 폴리예폭시, 폴리에틸렌 및 폴리스틸렌으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 고분자 물질이거나 유리로 이루어질 수 있다. 더욱 바람직하게는 상기 기재층(251)은 폴리에틸렌테레프탈레이트일 수 있다. 상기 기재층(251)의 역할은 지지기판으로서의 역할을 수행하며 복합적인 다중계도 사용 가능하다.
- <27> 상기 광-열변환층(252)은 적외선-가시광선 영역의 빛을 흡수하여 상기 빛의 일부분을 열로 변환시키는 층이며, 빛을 흡수하기 위한 광흡수성 물질을 포함하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 광-열변환층(252)은 Al, Ag 및 이들의 산화물 및 황화물로 이루어진 금속막이거나 카본 블랙, 흑연 또는 적외선 염료를 포함하는 고분자로 이루어진 유기막으로 이루어질 수 있다. 여기서, 상기 금속막은 진공 증착법, 전자빔 증착법 또는 스퍼터링을 이용하여 형성할 수 있으며, 상기 유기막은 통상적인 필름 코팅 방법으로서, 그라비아(Gravure), 압출(extrusion), 스핀(spin) 및 나이프(knife) 코팅방법 중에 하나의 방법에 의해 형성될 수 있다.
- <28> 상기 가스생성층(미도시)은 광 또는 열을 흡수하면 분해반응을 일으켜 질소 가스나 수소 가스 등을 방출함으로써 전사에너지를 제공하는 역할을 수행하며, 사질산펜타에리트리트(PETN), 트리니트로톨루엔(TNT)등으로 선택된 물질로 이루어진다.
- <29> 상기 전사층(253)은 정공주입층, 정공수송층, 유기발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층으로 이루어진 군에서 선택되는 하나의 단층막 또는 하나 이상의 다층막으로 이루어질 수 있다.
- <30> 상기 정공주입층은 유기전계발광소자의 유기발광층에 정공주입을 용이하게 하며 소자의 수명을 증가시킬 수 있는 역할을 한다. 상기 정공주입층은 아릴 아민계 화합물 및 스타버스터형 아민류등으로 이루어질 수 있다. 더욱 상세하게는 4,4',4"-트리스(3-메틸페닐아미노)트리페닐아미노(m-MTDATA), 1,3,5-트리스[4-(3-메틸페닐아미노)페닐]벤젠(m-MTDATB) 및 프타로시아닌 구리(CuPc)등으로 이루어질 수 있다.
- <31> 상기 정공수송층은 아릴렌 디아민 유도체, 스타버스터형 화합물, 스피로기를 갖는 비페닐디아민유도체 및 사다리형 화합물등으로 이루어질 수 있다. 더욱 상세하게는 N,N-디페닐-N,N'-비스(4-메틸페닐)-1,1'-바이페닐-4,4'-디아민(TPD)이거나 4,4'-비스[N-(1-나프틸)-N-페닐아미노]비페닐(NPB)일 수 있다.
- <32> 상기 유기발광층은 적색발광재료인 Alq3(호스트)/DCJTb(형광도펀트), Alq3(호스트)/DCM(형광도펀트), CBP(호스

트)/PtOEP(인광 유기금속 착체) 등의 저분자 물질과 PFO계 고분자, PPV계 고분자등의 고분자물질을 사용할 수 있으며, 녹색발광재료인 Alq3, Alq3(호스트)/C545t(도펀트), CBP(호스트)/IrPPY(인광 유기물 착체) 등의 저분자 물질과 PFO계 고분자, PPV계 고분자등의 고분자물질을 사용할 수 있다. 또한, 청색발광재료인 DPVBi, 스피로-DPVBi, 스피로-6P, 디스틸벤젠(DSB), 디스트릴아릴렌(DSA)등의 저분자 물질과 PFO계 고분자, PPV계 고분자등의 고분자물질을 사용할 수 있다.

- <33> 상기 정공억제층은 유기발광층내에서 전자이동도보다 정공이동도가 큰 경우 정공이 전자주입층으로 이동하는 것을 방지하는 역할을 한다. 여기 상기 정공억제층은 2-비페닐-4-일-5-(4-t-부틸페닐)-1,3,4-옥시디아졸(PBD), 스피로-PBD 및 3-(4'-t-부틸페닐)-4-페닐-5-(4'-비페닐)-1,2,4-트리아졸(TAZ)로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어질 수 있다.
- <34> 상기 전자수송층은 전자가 잘 수용할 수 있는 금속화합물로 이루어지며, 캐소드 전극으로부터 공급된 전자를 안정하게 수송할 수 있는 특성이 우수한 8-하이드로퀴놀린 알루미늄염(Alq3)으로 이루어질 수 있다.
- <35> 상기 전자주입층은 1,3,4-옥시디아졸 유도체, 1,2,4-트리아졸 유도체 및 LiF로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 물질로 이루어질 수 있다.
- <36> 또한, 이와 같은 유기막은 압출, 스핀, 나이프 코팅방법, 진공 증착법, CVD등의 방법에 의해 형성될 수 있다.
- <37> 상기 도너기판(250)은 상기한 층들뿐만 아니라 다양한 용도를 갖는 층들을 더욱 포함할 수 있으며, 그 용도에 따라서 적층 구조를 변경하여 사용할 수 있다.
- <38> 이어서, 상기 기판(261)의 화소영역과 상기 도너기판의 전사층(253)이 서로 대향하도록 서로 이격되어 배치한 후, 균일하게 라미네이션(lamination)한다.
- <39> 상기 라미네이션은 롤러, 기체 가압 또는 크라운 프레스를 사용하여 가압함으로써 이루어진다. 상기 라미네이션은 중앙에서 외곽으로 나가는 방향으로 진행할 수 있다. 또한, 상기 라미네이션은 단방향으로 진행할 수 있다.
- <40> 상기 라미네이션을 중앙에서 외곽으로 나가는 방향으로 할 경우, 상기 도너기판(250)과 상기 기판(261) 사이의 버블이 효과적으로 방지 될 수 있으므로, 중앙에서 외곽으로 나가는 방향으로 라미네이션을 하는 것이 더욱 바람직하다.
- <41> 한편, 상기 기판(261) 및 상기 도너기판(250)과는 별도로 레이저 조사장치(200)를 제공한다. 상기 레이저 조사장치(200)는 광원장치(210), 시준렌즈(collimation lens: 220), 대칭 디오이 렌즈 어레이(symmetrical DOE lens array: 230) 및 마스크(240)를 포함한다.
- <42> 상기 광원장치(210)는 상기 전사층(253)을 상기 도너기판(250)으로부터 분리하여 상기 기판(261)상에 전사시켜 소정의 패턴을 형성하는데 필요한 레이저빔(270)을 발생시킨다.
- <43> 상기 시준렌즈(220)는 상기 광원장치(210)에서 출사된 레이저빔(270)을 평행화하는 역할을 한다.
- <44> 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이(230)는 빛의 회절현상을 이용하는 광소자로서, 위상을 일치시키는 방법을 이용하여 빛을 한 점으로 수렴시킨다. 광원에서 나온 레이저빔이 상점까지 다다른 동안 각 경로를 지난 레이저빔들이 동일한 광경로를 갖지 않으나 동일한 위상으로 상점에 도달하게 되므로 얇은 두께의 소자로 굴절렌즈에서 동일한 광경로를 지난 것과 같은 효과를 갖게된다.
- <45> 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이(230)는 복수의 대칭 디오이 렌즈(230a)의 조합으로 이루어져 있다. 이로 인하여, 상기 레이저 조사장치(200)는 동시에 동일색의 복수의 화소를 패턴할 수 있는 멀티 스캔 방식을 수행하여 유기 전계발광소자를 제조할 수 있다.
- <46> 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이(230)는 상기 시준렌즈(220)와 상기 마스크(240) 사이를 상하로 이동 가능하기 때문에 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)의 초점 거리를 조절할 수 있으므로 화소영역의 패턴크기를 자유자재로 조절할 수 있다.
- <47> 도 3b는 본 발명에 의한 레이저 조사장치의 대칭 디오이 렌즈와 단위화소 즉, 유기막 패턴과의 관계를 설명한 단면도이다.
- <48> 도 3b를 참조하면, 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)의 피치를 P1, 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)의 지름을 S1, 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)의 초점거리를 f1, 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)와 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 중의 어느 하나를 나타내는 단위 화소까지의 거리를 d, 상기 단위 화소의 너비를 S2, 상기 적색(R), 녹색(G) 및 청색

(B) 각 단위 화소의 너비의 합을 P2 로 표기한다.

- <49> 여기서, 상기 대칭 디오이 렌즈의 초점거리(f1)의 범위는 10~300mm 이다. 상기 초점거리(f1)가 10mm 이하이면 패터닝이 실시 될 때 기관과 렌즈 사이에 도너기관 외에 기타 부수적인 장치가 들어갈 수 없는 공간을 확보할 수 없고 스캔을 할 때 이격 공간이 없어 작동이 원활하지 않을 수 있다. 또한, 300mm이상이면 장치의 크기가 너무 커지는 문제점이 발생한다.
- <50> 상기 대칭 디오이 렌즈와 화소와의 거리(d)는 20/3~200mm 이다. 상기 디오이 렌즈와 화소와의 거리(d)한정의 이유는 상기 대칭 디오이 렌즈의 초점거리(f1)의 범위한정의 이유와 동일하다.
- <51> 상기 화소를 대략 50~300ppi(pixel per inch)로 제작한다고 하면, 화소의 크기(P2)는 60~500 μ m 이다. 또한 상기 대칭 디오이 렌즈의 지름(P1)은 화소(P2)의 크기와 같다. 상기 레드(R), 그린(G) 및 블루(B)중 어느 하나를 나타내는 단위화소(S2)의 크기는 20~500/3 μ m이다.
- <52> 이어서, 이를 간단한 수식으로 정리하면, 한 픽셀 당 R, G, B 3개의 칼라를 패터닝해야 하므로,
- <53> $P2:S2= 3:1$ <----(1)
- <54> 삼각형의 정리를 이용하면
- <55> $f1:f1-d=3:1$ <----(2)
- <56> $f1:f1-d=S1:S2$ <----(3)
- <57> (2)식에서 $d=2 \times f1/3$ <----(4)
- <58> (3)식에서 P1 과 S2는 같으므로
- <59> $(f1-d) \times P1=f1 \times S2$ <----(5)
- <60> 위식에 (4)을 대입하면
- <61> $S2=P1/3$ <----(6) 으로 식이 주어진다.
- <62> (실시 예)
- <63> 17인치 UXGA를 제작할 때, 픽셀수는 1600 $\times$ 1200 이다. 픽셀 피치는 72 $\times$ 216 μ m가 된다. 이때 레이저 조사장치를 설계해보면 다음과 같다.
- <64> f1을 20cm 로 한다면, S2는 72 μ m이다.
- <65> (6)식을 도입하면, P1은 216 μ m, d는 13.34cm 이다.
- <66>
- <67> 이어서, 도 3a를 다시 참조하면, 상기 대칭 디오이 렌즈 어레이(230)는 투명성 재질인 유리 또는 플라스틱으로 구성되는 것이 바람직하다.
- <68> 도 5 는 본 발명에 따른 레이저 조사장치의 대칭 디오이 렌즈의 형상을 도시한 사시도이다.
- <69> 도 5를 참조하면, 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)의 형상은 블레이즈(blaze) 형상(a), 판상 형상(b) 및 계단 형상(c, d) 중에서 선택되는 어느 하나 일 수 있다. 도 3a 및 3b에서 도시된바와 같이 반구 형상일 수도 있다. 또한, 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)의 형상은 패턴의 크기에 따라 조절할 수 있으며, 특히 상기 계단형상(c, d)의 대칭 디오이 렌즈(230a)의 경우에는 패턴을 미세하게 제조하기 위하여 계단의 수를 증가시킬 수도 있다.
- <70> 이어서, 상기 마스크(240)는 상기 기관(261) 상에 패터닝 하고자 하는 픽셀 배치에 대응하도록 여러 가지 모양으로 패터닝된다. 상기 마스크(240)의 개구부의 배치 모양에 따라 예를 들면, 텔타 방식으로 개구부가 배치되면 텔타 방식으로 픽셀이 패터닝 될 수 있다.
- <71> 이어서, 상기 레이저 조사장치(200)의 광원장치(210)에서 발생한 레이저빔(270)은 상기 시준렌즈(220)를 통과함으로써 평행화되고, 상기 평행화된 레이저빔(270)이 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)를 통과하면 회절현상이 일어난다. 상기 대칭 디오이 렌즈(230a)를 통과한 레이저빔은 입사광을 회절시키는 각도가 광축 근방의 중앙부에 대해 크게, 주변부에 대해서는 작게 되도록 형성되어 있다. 따라서 레이저빔은 각기 다른 회절각도를 가지게 되고 상기 마스크(240) 표면에서 위상 결맞음이 일어나 일정하게 패터닝된 레이저빔의 형상을 띄게 된다.

- <72> 이어서, 상기 마스크(240) 상에는 일정거리로 패터닝 된 레이저빔이 도달하고, 상기 패터닝된 레이저빔은 상기 마스크(240)를 통과하여 상기 전사층(253)을 상기 기판(261) 상에 전사를 수행하여 유기막층 패턴(미도시)을 형성한다.
- <73> 여기서, 상기 레이저 조사장치(200)를 이용하여 유기막층 패턴을 형성하는 전사 공정은 N_2 분위기에서 이루어질 수 있다. 이는 대기 중에 존재하는 산소에 의해 상기 유기막층 패턴의 산화를 방지하기 위함이다. 여기서 N_2 분위기를 조성하기에 많은 시간과 비용을 투자해야 하므로, 상기 유기막층이 산소나 수분의 영향을 미치지 않는 조건을 고려하여 O_2 및 H_2O 가 각각 100ppm이하의 분위기가 조성될 때까지 N_2 를 충전하는 것이 바람직하다.
- <74> 또한, 상기 전사 공정은 진공 분위기에서 이루어질 수 있는데, 상기 도너기판을 상기 기판 전면에 라미네이션하는 공정시 상기 도너기판과 상기 기판사이의 기포 발생을 억제할 수 있는 효과가 있다.
- <75> 도 4 는 본 발명의 의한 레이저 조사장치로 패터닝한 화소의 평면도이다.
- <76> 도 4를 참조하면, 상기 기판(261)에 형성된 각 픽셀에 레드(R), 블루(B), 그린(G) 등의 단위화소가 레이저 스캔 방향으로 다양하게 패터닝 되어 있다. 상기 레이저 조사장치(200)의 마스크(240)를 이용하여 불필요한 부분은 차단했기에 원하는 단위화소를 각 픽셀에 레이저 스캔 방향과 관계없이 패터닝 할 수 있다.
- <77> 이상에서와 같이, 본 발명은 대칭 디오이 렌즈 어레이 및 마스크를 구비한 레이저 조사장치를 이용하여 유기전계발광소자를 제조함으로써 다양한 픽셀배치 방법을 행할 수 있는 장점이 있다.
- <78> 본 발명을 특정의 바람직한 실시 예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명이 그에 한정되는 것이 아니고, 이하의 특허청구범위에 의해 마련되는 본 발명의 정신이나 분야를 이탈하지 않는 한도 내에서 본 발명이 다양하게 개조 및 변화될 수 있다는 것을 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자는 용이하게 알 수 있을 것이다.

발명의 효과

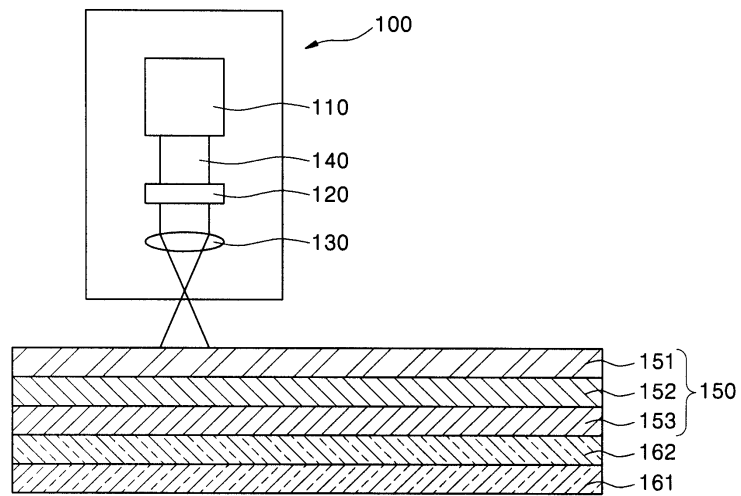
- <79> 이상에서와 같이, 본 발명은 대칭 디오이 렌즈 어레이 및 마스크를 구비한 레이저 조사장치를 이용하여 유기전계발광소자를 제조함으로써 다양한 픽셀 배치 방법을 수행할 수 있는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

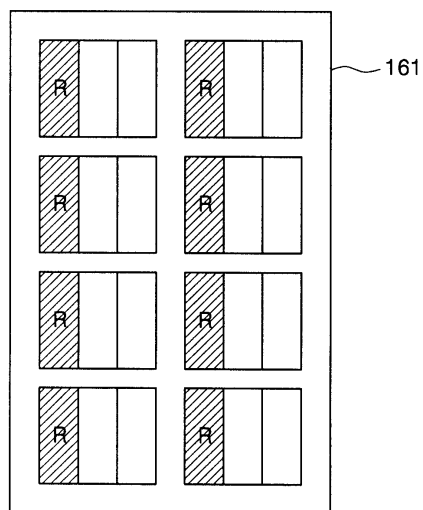
- <1> 도 1 은 종래의 레이저 조사장치를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법을 설명하기 위한 모식도.
- <2> 도 2 는 종래의 레이저 조사장치로 패터닝된 픽셀을 나타낸 평면도.
- <3> 도 3a 는 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 조사장치를 이용한 유기전계발광소자의 제조방법을 설명하기 위한 모식도.
- <4> 도 3b 는 본 발명에 의한 레이저 조사장치의 대칭 디오이 렌즈와 화소와의 관계를 설명한 단면도.
- <5> 도 4 는 본 발명의 의한 레이저 조사장치로 패터닝된 픽셀을 나타낸 평면도
- <6> 도 5 는 본 발명에 따른 레이저 조사장치의 대칭 디오이 렌즈의 형상을 도시한 사시도.

도면

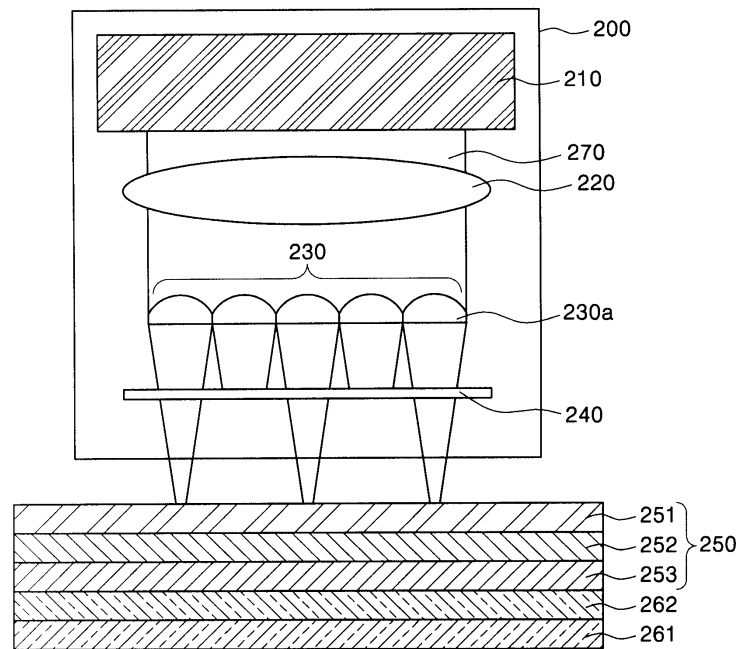
도면1



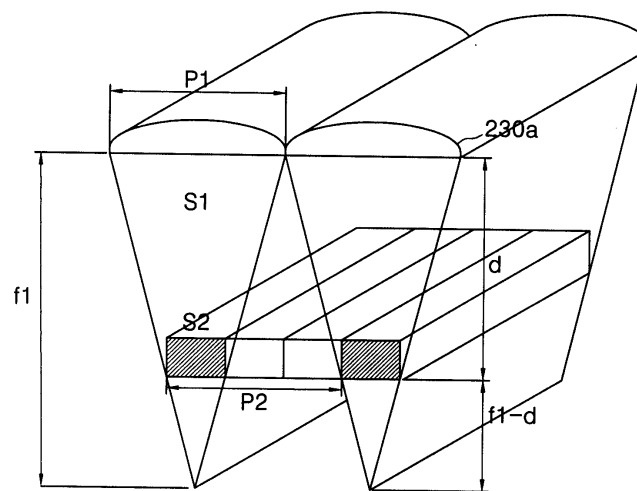
도면2



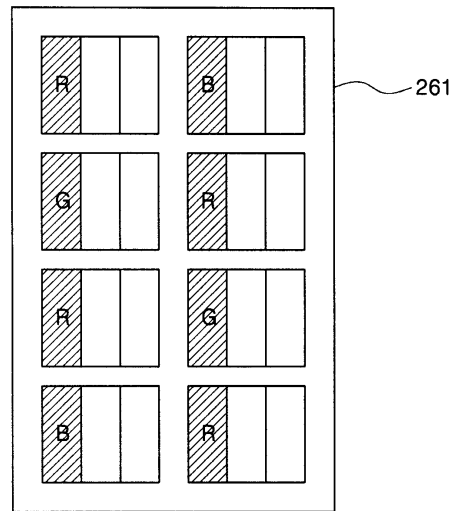
도면3a



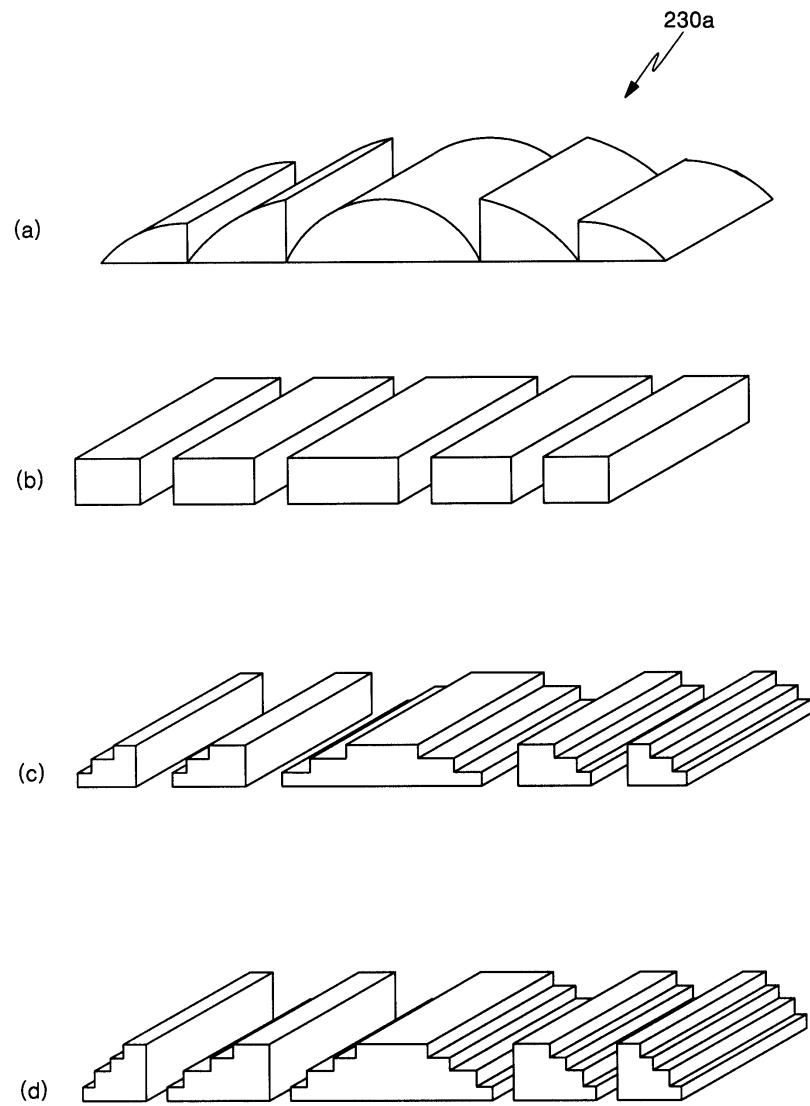
도면3b



도면4



도면5



专利名称(译)	激光照射装置及使用该装置的有机电致发光装置的制造方法		
公开(公告)号	KR1020080006998A	公开(公告)日	2008-01-17
申请号	KR1020060066444	申请日	2006-07-14
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	KWAK NOH MIN 광노민 KANG TAE MIN 강태민 LEE JAE HO 이재호 LEE SEONG TAEK 이성택		
发明人	광노민 강태민 이재호 이성택		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	G02B27/0037 B23K26/0648 B23K26/066 G02B27/30 G02B3/0006 H01L51/56 H01L51/0015 H01L51/0013		
代理人(译)	Baksangsu		
其他公开文献	KR100796595B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

目的：提供一种激光照射装置和制造有机发光显示装置的方法，以通过在真空条件下进行转移过程来防止第一和第二基板之间的蒸汽。组成：激光照射装置包括光源，准直透镜，对称DOE（衍射光学元件）透镜阵列（230a）和掩模。准直透镜布置在光源下方。对称DOE透镜阵列布置在准直透镜下方。掩模布置在对称的DOE透镜阵列下方。对称DOE透镜阵列包括多个对称的DOE透镜，其由透明材料制成。对称DOE透镜阵列在准直透镜和掩模之间垂直移动。©KIPO 2008

